

# 2SA606, 607/2SC959, 960

PNP/NPN エピタキシャル形シリコントランジスタ/

PNP/NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR

低周波増幅用/Audio Frequency Amplifier

## 特 徴/FEATURES

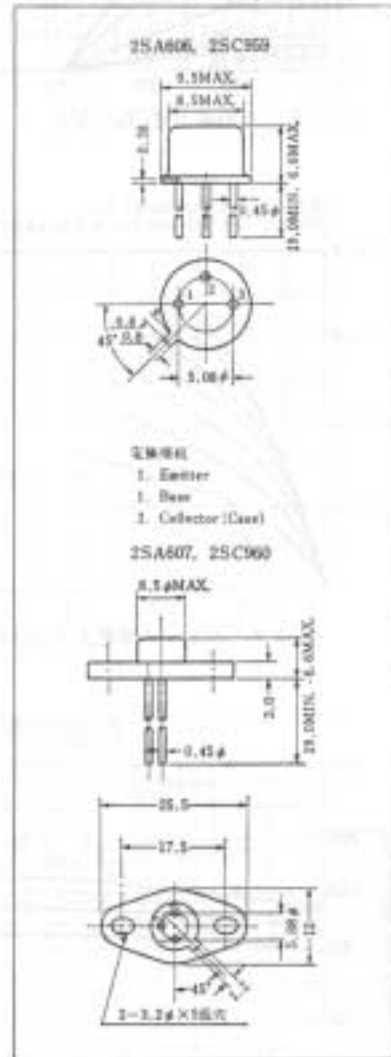
- ・実効出力30~50Wのステレオアンプのドライバとして最適。  
Suitable for Driver of 30 to 50 watts Audio Amplifiers.
- ・電流増幅率の電流に対するリアリティがよい。  
Excellent Current gain linearity.

絶対最大定格/ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

項 目	略 号	2SA606	2SA607	2SC559	2SC960	単位
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CB0}$	-100	-100	120	120	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CE0}$	-80	-80	80	80	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EB0}$	-5.0	-5.0	5.0	5.0	V
コレクタ電流(直流)	$I_{C(DC)}$	-0.7	-0.7	0.7	0.7	A
コレクタ電流(パルス)	$I_{C(pulse)}^*$	-1.2	-1.2	1.2	1.2	A
全損失	$P_T(T_C=25^\circ\text{C})$	0.7	1.0	0.7	1.0	W
ジャンクション温度	$T_j$		150			$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$		-65~+150			$^\circ\text{C}$

\*  $PW \leq 10\text{ms}$ , duty cycle  $\leq 50\%$ 電気的特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタしゃ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = 80\text{V}$ , $I_E = 0$			3.0	$\mu\text{A}$
エミッタしゃ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = 5.5\text{V}$ , $I_C = 0$			3.0	$\mu\text{A}$
直流電流増幅率	$h_{FE1}$	$V_{CE} = 5.0\text{V}$ $I_C = 10\text{mA}^*$	20			
	$h_{FE2}$	$V_{CE} = 5.0\text{V}$ $I_C = 200\text{mA}^*$	40	80	200	
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 500\text{mA}$ $I_E = 50\text{mA}^*$			2.0	V
利得帯域幅積	$f_T$	$V_{CE} = 10\text{V}$ $I_C = 100\text{mA}$	50			MHz
コレクタ容量	$C_{ob}$	$V_{CB} = 10\text{V}$ , $I_E = 0$			50	pF

\* パルス測定  $PW \leq 350\mu\text{s}$  duty cycle  $\leq 2\%$ /pulsed $h_{FE}$  区分/ $h_{FE}$  classification $h_{FE2}/N: 40\sim 80$  M: 60~110 L: 90~150 K: 130~200外形図/PACKAGE DIMENSIONS  
(Unit:mm)

This datasheet has been downloaded from:

[www.DatasheetCatalog.com](http://www.DatasheetCatalog.com)

Datasheets for electronic components.